

學位論文系助審查流程

1. 登入論文系統 <https://cloud.ncl.edu.tw/asia/>

館務公告 活動公告 人力招募

類別	標題	張貼日期
館務公告	重要 熱門 110學年度35學(假)借書公告	2021-12-09
館務公告	敬請踴躍申請"110學年第二學期教授指定用書",以利學生借閱課程所需圖書及視聽資料!	2021-12-21
館務公告	110學年度(2022年)訂購電子資源清單,歡迎全校師生多加利用~	2021-12-17

◆ 圖書館網頁 → 電子資源 → **博碩士論文系統**

空間名稱	空間區域	尚有空間[更新]
團體討論室	3F 討論室	2
視聽欣賞室	3F 視聽欣賞室	3
AI練功坊	2F AI練功坊	0
研究小間	3F 研究小間	0

週六/日 09:30~17:30 ▶ 由阿美廣場進入

館藏查詢

- 館藏查詢系統 (我的書房)
- 期刊查詢
- 亞太二十週年特刊
- 教授指定用書
- 新書通報
- 考古羅

電子資源

- VOD線上隨選視訊系統
- 博碩士論文系統 (建議使用chrome)
- 360Link文獻動態連結服務
- AI閱讀專區

Asia University, Taiwan 亞洲大學

Asia University, Taiwan 亞洲大學

Asia University 博碩士論文系統

ndtdcc.ncl.edu.tw/asia/

請注意一般生帳號與在職生帳號不同

論文建檔與管理 Submission

論文查詢 Search

最新消息 News

建檔流程 Upload Workflow

建檔說明 User Guides

下載區 Download

相關連結 Related Links

帳號: _____

密碼: _____

Go

2. 點選「研究生論文審核」進行查核

亞洲大學博碩士論文系統

研究生帳號維護 (共 17 筆)

學年度: [102]

新增帳號 刪除帳號 全體寄信 匯入帳號 匯出帳號

全選	帳號	密碼	姓名	學年度	學號	寄信狀態	動作
<input type="checkbox"/>	1					寄送紀錄	修改 寄信 審核退回 模擬
<input type="checkbox"/>	2					寄送紀錄	修改 寄信 審核退回 模擬
<input type="checkbox"/>	3					寄送紀錄	修改 寄信 審核退回 模擬
<input type="checkbox"/>	4					寄送紀錄	修改 寄信 審核退回 模擬
<input type="checkbox"/>	5					寄送紀錄	修改 寄信 審核退回 模擬
<input type="checkbox"/>	6					寄送紀錄	修改 寄信 審核退回 模擬
<input type="checkbox"/>	7					寄送紀錄	修改 寄信 審核退回 模擬
<input type="checkbox"/>	8					寄送紀錄	修改 寄信 審核退回 模擬
<input type="checkbox"/>	9					寄送紀錄	修改 寄信 審核退回 模擬
<input type="checkbox"/>	10					寄送紀錄	修改 寄信 審核退回 模擬

目前在第 1 頁 / 共 2 頁

跳至 1 頁

3. 點選“審核”

亞洲大學博碩士論文系統

研究生論文審核

論文中文名稱	論文英文名稱	姓名	全文檔	狀態	動作
1 以計畫行為理論探討國小樂樂棒球 球員從事棒球運動之行為意圖			有	待審中	修改 審核

目前在第 1 頁 / 共 1 頁

4. 論文基本資料查核

基本資料	中外文摘要	目錄	參考文獻	電子全文	備份全文
論文種類:	代替論文: 技術報告 (應用科技類)				
研究生中文名:					
研究生外文名:					
論文中文名稱:					
論文外文名稱:					
指導教授:					
中文名:	呂佳祐				
外文名:	LU,CHIA-JU				
指導教授E-mail:	jareeh@asia.edu.tw				
口試委員:					
中文名:	林銘昌				
外文名:	LIN,MING-CHANG				
中文名:	呂佳祐				
外文名:	LU,CHIA-JU				
中文名:	張祐誠				
外文名:	CHANG,YU-CHENG				
口試日期:	2020-06-02				
學位類別:	碩士				
院校名稱:	亞洲大學				
系所名稱:					
專業學年度:	108				
論文出版年:	2020				
學號:					
語文別:	中文				
論文頁數:	94				
中文關鍵字:	灌溉用水污染 高污染潛勢評估 離子交換樹脂 水質改善				

1. 論文種類依實際狀況點選,點選處見下圖
2. 紙本論文封面原「碩士論文」字樣需和系統設定的論文種類一致,分為「碩士論文」、「碩士專業實務報告」及「碩士技術報告」(如下圖)(書背也一併修改)

外籍生若無中文名, 中文名欄請貼英文

外籍生若無中文論文名稱, 請貼英文論文名稱; 外文名稱字首大寫

姓在前加逗號, (逗號後要空一格) 名字在後; 或名在前 姓在後, 請大寫, 例: 王大華英文名書寫方式: WANG, DA-WA 或 WANG, DA WA 或 WANG, DAWA 或, DA-WA, WANG 或 DA WA, WANG 或 DAWA, WANG

指導教授也是口試委員, 請務必加

審定書需與口試日期一致(自 111/6/24 起因有學系對審定書上日期有不同意見,故圖書館不複查口試日期欄位,但仍會提醒不同處,自行斟酌是否正確即可)

頁數為論文最後一頁頁碼或 PDF 檔總頁數皆可

1. 各關鍵字需分欄填寫。
2. 外籍生若無中文關鍵字, 請於中文關鍵字欄填入英文關鍵字。



5. 中英文摘要

論文中文摘要：

Nanoimprint Lithography:
Si master molds are generally patterned by electron-beam lithography (EBL) that is known to be a time consuming nano patterning technique. Thus, developing mold duplication process based on high throughput technique such as nanoimprint lithography can be helpful in reducing its fabrication time and cost. The NEB22 A2, mr-I 7000E series negative e-beam resist possess a variety of characteristics desirable for NIL, such as low viscosity, low bulk-volumetric shrinkage, high Young's modulus, high thermal stability, and excellent dry-etch resistance. The excellent oxygen-etch resistance of the barrier material enables a final transfer pattern that is about three times higher than that of the original NIL mold. Based on these imprint on negative photo resist approach is used for pattern transfer into silicon substrates. The result is a high-resolution pattern with feature sizes in the range of nanometer to several microns. We combine Simprint Core simulation software for simulating nanoimprint process and to achieve uniform RLT. Our research results in low RLT as 10-20nm thicknesses for mr-I 7020E photoresist. The simulation results and experimental results are matching. A plot of how RLT across the whole stamp region changes with imprinting duration is shown using simulation. The central, thick line shows the average RLT across the entire stamp, the thin lines indicate the stamp-average RLT plus and minus one standard deviation of the cross-stamp RLT values. Simulated and calibrated for uniform residual layer thickness (RLT) and the cross-sections of RLT are plotted. In cavity filling value of 0 denotes completely empty cavities; a value of 1 in a particular location means that cavities are completely filled in that region. We have achieved completely filled cavities, i.e., value of 1 at all locations. We have achieved RLT around 10nm and even RLT at all location in pattern using mr-I 7020E photoresist imprint.

論文外文摘要：

Nanoimprint Lithography:
Si master molds are generally patterned by electron-beam lithography (EBL) that is known to be a time consuming nano patterning technique. Thus, developing mold duplication process based on high throughput technique such as nanoimprint lithography can be helpful in reducing its fabrication time and cost. This study aims to develop capabilities in patterning nano structure using thermal nano-imprint lithography. The NEB22 A2, mr-I 7000E series negative e-beam resist possess a variety of characteristics desirable for NIL, such as low viscosity, low bulk-volumetric shrinkage, high Young's modulus, high thermal stability, and excellent dry-etch resistance. The excellent oxygen-etch resistance of the barrier material enables a final transfer pattern that is about three times higher than that of the original NIL mold. Based on these imprint on negative photo resist approach is used for pattern transfer into silicon substrates. The result is a high-resolution pattern with feature sizes in the range of nanometer to several microns. We combine Simprint Core simulation software for simulating nanoimprint process and to achieve uniform RLT. Our research results in low RLT as 10-20nm thicknesses for mr-I 7020E photoresist. The simulation results and experimental results are matching. A plot of how RLT across the whole stamp region changes with imprinting duration is shown using simulation. The central, thick line shows the average RLT across the entire stamp, the thin lines indicate the stamp-average RLT plus and minus one standard deviation of the cross-stamp RLT values. Simulated and calibrated for uniform residual layer thickness (RLT) and the cross-sections of RLT are plotted. In cavity filling value of 0 denotes completely empty cavities; a value of 1 in a particular location means that cavities are completely filled in that region. We have achieved completely filled cavities, i.e., value of 1 at all locations. We have achieved RLT around 10nm and even RLT at all location in pattern using mr-I 7020E photoresist imprint.

GaN GAA Nanowire:
To increase typically low output drive currents from Si Nanowire field-effect transistors (FETs), we show a GaN based GAA Nanowire FET's effectiveness. The theoretical study is focused on the three dimensional device designs, comparisons, random dopant fluctuation using IFM, and general variability issues including nanowire length, gate work function, and channel thickness are discussed. Performance of GaN GAA Nanowire is found to be increasing as Gate length is increased. Electrical characteristics of FETs including threshold voltage saturation, On/Off current ratio and sub threshold slope (SS) are analysed. GaN GAA structure let to gate control ability improvement compared to Si based Nanowire in electrical performance. The GaN GAA Nanowire subthreshold slope is ~62mV/decade, which is close to the theoretical limit 60 mV/decade and leads to very high Ion/loff ratio of 10¹⁰-10¹¹. The GaN GAA Nanowire is a very promising candidate for high-performance.

6. 確認貼上目錄/圖目錄/表目錄

基本資料 中外文摘要 目錄 參考文獻 電子全文 備份全文

目錄
中文摘要 I
英文摘要 III
目錄 V
圖目次 VII
表目次 VIII
第一章 緒論 1
第一節 研究背景與動機 1
第二節 研究目的 2
第三節 研究流程 3
第四節 研究架構 4
第二章 文獻探討 5
第一節 霧棠活動的發展與相關研究 5
第二節 霧棠活動者個人背景資料之探討 10
第三章 環境態度 11
第一節 環境行為 18
第二節 環境態度與環境行為 22
第四章 研究方法 24
第一節 研究架構 24
第二節 研究對象 25
第三節 研究問卷 26
第四節 問卷設計 26
第五節 資料分析方法 30
第四章 研究結果與分析 31
第一節 信、效度分析 31
第二節 基本資料分析 33
第三節 環境態度 37
第四節 環境行為 47
第五節 環境態度與環境行為 57
第五章 結論與建議 60
第一節 研究結論 60
第二節 研究建議 62
參考文獻 65
附錄一 72

圖目次
圖 1 研究流程圖 3
圖 3 研究架構圖 24

論文目次：
表目錄
表 1 霧棠的定義 5
表 2 研究對象背景表 8

1. 確認目錄/圖目錄/表目錄是否均貼上?
2. 抽驗紙本及電子檔論文頁碼是否一致且正確?
例如:第四章在第 69 頁, 請查 PDF 檔的第四章頁碼是否為 69?

7. 參考文獻查核

論文審查簡章.docx - Microsoft Word

臺灣博碩士論文知識加值系統管理平臺 - Mozilla Firefox

檢視資料

基本資料 中外文摘要 目錄 參考文獻 全文原始檔 已轉檔全文

- [1] Ronse, K. Optical lithography – a historical perspective. C. R. Physique 7 (2006), pp. 844–857.
- [2] Lawes, R.A. Future trends in high-resolution lithography. Appl. Surf. Sci. 154–155 (2000), pp. 519–526.
- [3] Lin, B.J. Optical lithography – present and future challenges. C. R. Physique 7 (2006), pp. 658–674.
- [4] Fay, B. Advanced optical lithography development from UV to EUV. Microelec- tron. Eng. 61–62 (2002), pp. 11–24.
- [5] Kernp, K. and Wurm, S. EUV lithography. C. R. Physique 7 (2006), pp. 875–895.
- [6] Packerar, M. C. and Maldonado, J. R. X-ray Lithography – An Overview. Proc. IEEE 81 (1993), pp. 1249–1274.
- [7] Iwamitsu, S., Nagao, M., Shahjada, S., Pahlavy, A., Nishimura, K., Kashihara, M., Momota, S., Nojiri, Y., Taniguchi, J., Miyamoto, I., Nakao, T., Morita, N. and Kawasegi, N. Ion beam lithography by using highly charged ion beam of Ar. Col. Ions and Surfaces A. Physicochem. Eng. Aspects 313–314 (2006), pp. 407–410.
- [8] Vieu, C., Carcenac, F., Pepin, A., Chen, Y., Mejias, M., Lebib, A., Manin- Farlazzo, L., Couraud, L. and Launois, H. Electron beam lithography: resolution limits and applications. Appl. Surf. Sci. 164 (2000), pp. 111–117.
- [9] Chou, S. Y., Krauss, P. R. and Renstrom, P. J. Imprint of sub-25 nm via and trenches in polymers. Appl. Phys. Lett. Vol. 67 No. 21 (1995), pp. 3114–3116.
- [10] Derbyshire, B. The ancient technique of imprint lithography could make a mark on next-generation wafer patterning. Semiconductor Manufacturing, July (2004), pp. 19–26.
- [11] Chou, S. Y., Krauss, P. R. and Renstrom, P. J. Nanoimprint lithography. J. Vac. Sci. Vol. B14, No. 6 (1996), pp. 4129–4133.
- [12] Chou, S. Y. and Kraus, P. R. Imprint Lithography with Sub-10 nm Feature Size and High Throughput. Microelectronic Eng. 35 (1997), pp. 237–240.
- [13.] Sotomayor Torres, C.M., Zankovych, S., Seekamp, J., Kamm, A.P., Cedeno, C. C., Heffmann, T., Ahopelto, J., Reuther, F., Pfeiffer, K., Bleidessel, G., Gruetzner, G., Maximov, M.V. and Heidari, B. Nanoimprint lithography: an alter- native nanofabrication approach. Mater. Sci. and Eng. C23 (2003), pp. 29–31.
- [14.] Guo, L.J. Recent progress in nanoimprint technology and its applications. J. Phys. D: Appl. Phys. 37 (2004), pp. R123–R141.
- [15.] Alternative Lithography: Unleashing the potentials of Nanotechnology, edited by Sotomayor-Torres, C. M., University of Wuppertal, Kluwer Academic/Plenum Publishers, New York 2003.
- [16.] Becker, H. and Heim, U. Hot embossing as a method for the fabrication of poly- mer high aspect ratio structures. Sensors and Actuators 83 (2000), pp. 130–135.
- [17.] Yokoo, A., Suzuki, H. and Notomi, M. Organic Photonic Crystal Band Edge Laser Fabricated by Direct Nanoimprinting. Japanese Journal of Applied Phys- ics 43 (2004), pp. 4009–4011.
- [18.] Hoon Kim, S., Lee K-D., Kim J-Y., Kwon M-K. and Seong-Ju Park. Fabrication of photonic crystal structures on light emitting diodes by nanoimprint lithography. Nanotechnology 19 (2007), pp. 1–5.
- [19.] Kang, D.J., Bae, B.-S. and Nishi, J. Fabrication of Thermally Durable sub- wavelength Periodic Structures upon Inorganic Hybrid Materials by Nanoimprint- ing. Japanese

8. 全文 PDF 檔查核

檢視資料

1. 需為單一 PDF 檔案
2. 點選開啟論文 PDF 檔。
3. 檢查審訂書是否已掃描，並加入 PDF 檔?
4. PDF 檔需加浮水印。
5. PDF 檔不得設保全(如下圖)。
6. PDF 檔內容需與紙本論文、論文系統上的基本資料、中外文摘要、目錄、參考文獻所有欄位內容都要一致。

全文原始授權狀態: 校內於2015年05月30日, 校外於2015年05月30日開放

若畢業生在系統授權設定為延後公開時,請檢查

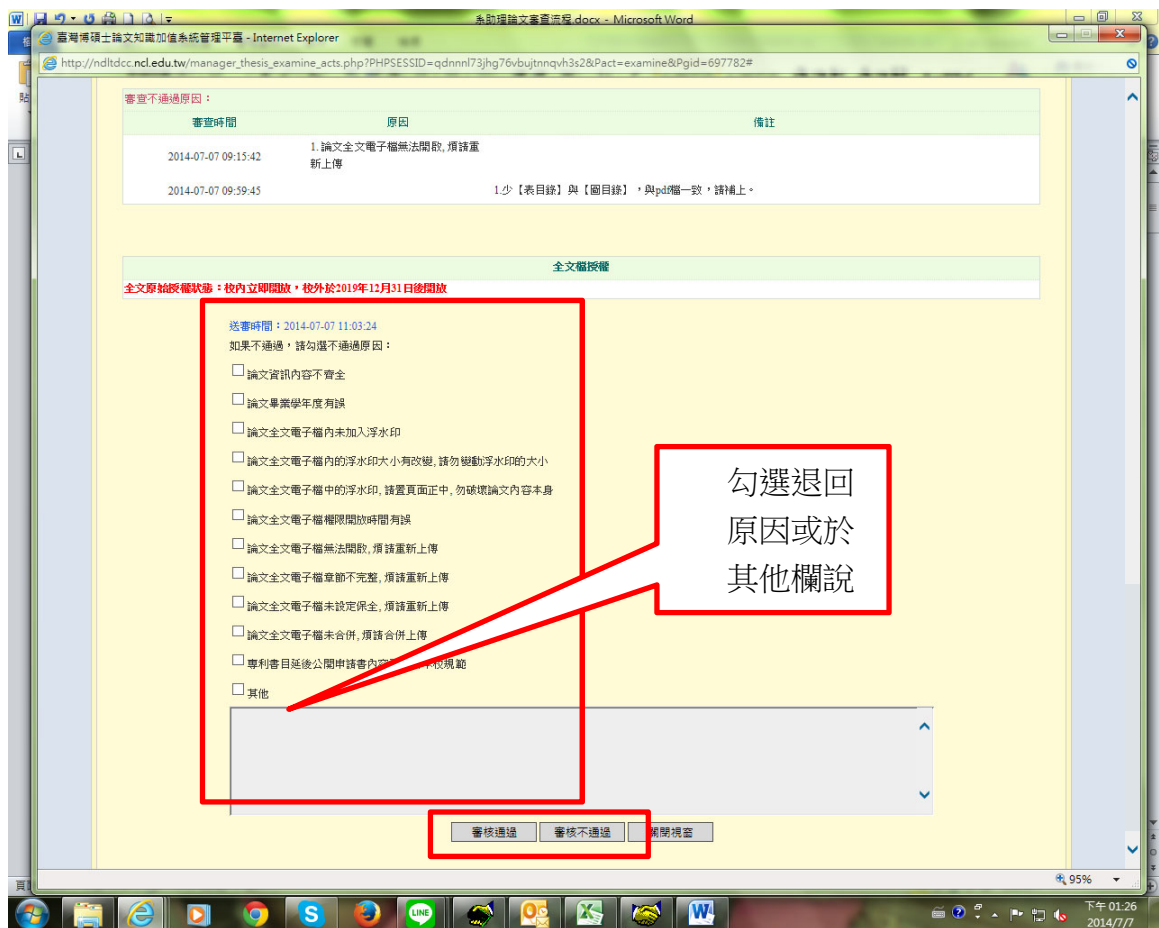
- 1)是否符合法規規定的 3 項原因: 涉及國家機密、發明專利或法律規定,
- 2)是否檢附延後公開申請書本校版及國圖版(另需將簽署完成的 2 項申請書掃描上傳至論文系統(step2)並設定公開日期
- 3)延後原因證明文件
- 4)經畢業生所屬學系學位論文延後公開審查委員會審查同意會議紀錄。

***電子全文已設保全圖示範例---不可以設保全**





10. 審核結果：點選「審核通過」或「審核不通過」



11. 紙本論文：檢查膠裝、封面（膠膜）、書背及封面顏色（雲彩紙，顏色有統一，圖例請至論文系統→下載區第8項）；紙本論文不需浮水印。
12. 依國家圖書館規定學位論文內不應含個人資訊，如電子郵件、電話、住址、身分證字號等，應抽出或隱蔽。

13. 申請延後公開注意事項(若無可跳過)

- (1) 依「亞洲大學學位論文管理要點」第六條,延後公開原因限於涉及**國家機密、發明專利,或依法律規定**而必須延後者。
- (2) 延後年限：至多以**2年**為限。
- (3) 申請延後公開辦理離校論文審查時需繳交之證明文件
 - 甲、「亞洲大學學位論文延後公開申請書」及「國家圖書館學位論文延後公開申請書」各**1份**(經由畢業生、指導教授及學系主管親筆簽名)。
 - 乙、延後原因之相關證明文件，
 - i. 涉及機密:提供相關單位開立該論文內容涉及國家機密之證明影本。
 - ii. 專利事項:填寫專利申請案號，或提供申請專利單位回覆之影本。
 - iii. 依法不得提供:填寫原因並檢附證明文件，例如論文之研究與公司或研究機構簽訂保密合約，提供保密合約的影本。
 - 丙、檢附經畢業生所屬學系學位論文延後公開審查委員會審查同意會議紀錄(委員由各學系**4至5名**助理教授級以上教師擔任)。
- (4) 申請紙本論文或摘要延後公開者需將已簽署完成本校及國家圖書之延後公開申請書掃描上傳至論文系統「**step2 上傳全文**」→「有申請紙本文延後公開者請點選此按鈕」→設定延後公開日期。
- (5) 審查時需注意
 - 甲、系統設定延後公開日期是否與上傳之申請書(請點選日期下方磁片圖示查看)一致。
 - 乙、需確認上傳之申請書各項欄位是否填寫完成、申請人/指導教授/系主任需親筆簽名及系所章戳用印完成。



14. 論文退件處理

當系助理已將研究生論文審核通過，但論文仍需修改時，則需向國家圖書館申請退件，申請退件步驟如下：

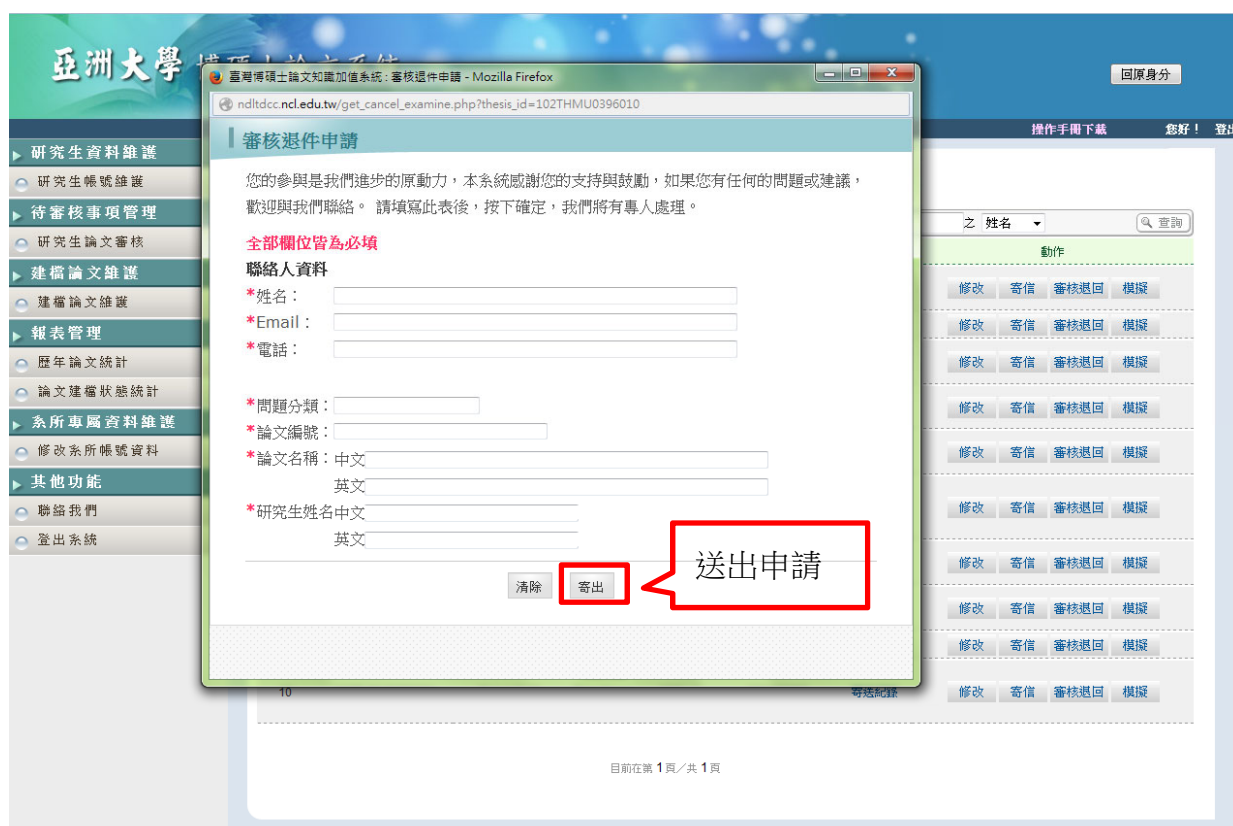
(1) 在研究生帳號後點選「審核退回」



在欲退件的研究生帳號，點選「審核退回」

全選	帳號	密碼	姓名	學年度	學號	寄信狀態	修改	寄信	審核退回	模擬
1						寄送紀錄				
2						寄送紀錄				
3						寄送紀錄				
4						寄送紀錄				
5						寄送紀錄				
6						寄送紀錄				
7						寄送紀錄				
8						寄送紀錄				
9						寄送紀錄				
10						寄送紀錄				

(2) 送出申請(通常國圖約 10-20 分鐘內處理完畢)(PS.國圖系統人員六日不上班)



審核退件申請

您的參與是我們進步的原動力，本系統感謝您的支持與鼓勵，如果您有任何的問題或建議，歡迎與我們聯絡。請填寫此表後，按下確定，我們將有專人處理。

全部欄位皆為必填

聯絡人資料

*姓名：

*Email：

*電話：

*問題分類：

*論文編號：

*論文名稱：中文
英文

*研究生姓名中文
英文

清除

送出申請

15. 當學期預計畢業但未畢業之研究生帳號應刪除：

- (1) 為使資訊正確，請於研究生口試完，且論文修正完成後再核發系統帳號及密碼；
- (2) 在教務處規定的論文繳交時程結束後，請將因故無法於該學期畢業之論文系統研究生帳號刪除。



16. 其他:

- (1) 置於本校論文系統→建檔說明→論文格式規範→各系所屬之論文格式規範 Department Thesis Format List,請各系若有更新者,回傳連結給我,以便一併更新網頁.

